

مطالعه‌ی سه‌بعدی اختلاط در ریز‌مخلوط‌گرهای با بار سطحی ناهمگن به کمک مدل

* هلمهولتز- اسمولوکوفسکی

جعفر جماعتی^(۱) حمید نیازمند^(۲) سیدعلی میربوزرگی^(۳)

چکیده در این مقاله اختلاط الکتروکیتیکی سه‌بعدی درون ریز‌مخلوط‌گرهای ساخته شده با ریز‌ مجرای ناهمگن به صورت کیفی و کمی بررسی شده است. برای کاهش هزینه‌های محاسباتی در جریان‌های سه‌بعدی، شبیه‌سازی جریان الکترواسموتیک با استفاده از روش هلمهولتز- اسمولوکوفسکی (Helmholtz-Smoluchowski) انجام شده است. مطالعات قبلی برای پذیره‌های اختلاط الکتروکیتیکی درون ریز‌ مجرای ناهمگن نشان داده است که وجود گردابهای و نواحی دارای جریان چرخشی بسته همواره باعث بهبود راندمان اختلاط در جریان‌های دو بعدی می‌گردد. اما بررسی‌های انجام شده در این مقاله برای ریز‌مخلوط‌گرهای سه‌بعدی نشان داد که همواره این اتفاق رخ نمی‌دهد و در برخی موارد وجود گردابهای افزایشی بر راندمان اختلاط ندارد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که میزان نامتقارانی در میان جریان سیال عامل تعیین‌کننده در ایجاد اختلاط است. از آنجا که در جریان‌های سه‌بعدی امکان ایجاد نامتقارانی بیشتر وجود دارد لذا میزان راندمان اختلاط در جریان‌های سه‌بعدی در مقایسه با جریان‌های دو بعدی بیشتر است. مطالعه‌ی آرایش‌های متنوع سه‌بعدی برای ریز‌مخلوط- گر الکترواسموتیکی نشان داد که بسته به آرایش ناهمگنی‌ها، راندمان اختلاط درون ریز‌ مجرای ناهمگن در مقایسه با ریز‌ مجرای همگن می‌تواند بهبود یابد و یا این که کاهش یابد. این نتایج تأکید می‌کند که بررسی دو بعدی اختلاط نمی‌تواند تمامی مزایای اختلاط درون ریز‌ مجرای ناهمگن را شرح دهد. یافته‌های این پژوهش می‌توانند در مدل‌سازی صحیح ریز‌مخلوط‌گرهای مورد استفاده در کاربردهای عملی به ویژه ریزتراسه‌های آزمایشگاهی (Lab-on-a-chip) مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی اختلاط سه‌بعدی، ریز‌مخلوط‌گر، جریان الکترواسموتیک، توزیع بار ناهمگن.

Investigation the 3D Mixing with Non-homogenous Surface Charges Using Helmholtz-Smoluchowski Model

J. Jamaati

H. Niazmand

S.A. Mirbozorgi

Abstract Numerical investigation of 3D electrokinetic mixing through micromixer has performed both qualitatively and quantitatively. In order to reduce numerical expenses of 3D flows, we implement the Helmholtz-Smoluchowski method for the numerical modeling of electroosmotic flows. According to the previous study of electrokinetic mixing inside the heterogeneous microchannels, existence of the vortexes within the flow field always increase the mixing performance for 2D flows. However, investigations of 3D micromixers show that this increase does not happen for all the situations and in some cases, existence of the vortexes does not enhance the mixing performance. Findings of this research indicate that the asymmetry degree of the flow field pattern is the key parameter for the mixing performance. Within the 3D flow field, there are more opportunities to increase the asymmetries. Consequently, mixing performances of the 3D flows are much larger compared to those of 2D flows. Studies of various 3D cases for electroosmotic micromixer show that mixing performance can be improved or deteriorated depending on the arrangement of the heterogeneities over the microchannel walls. These results confirmed that 2D simulation of mixing could not explain the complete benefits of passive micromixers. These results can apply to the simulation of micromixers used in Lab-on-a-chip devices.

Key Words 3DMixing, micromixer, electroosmotic flow, non-homogenous charge pattern

★ تاریخ دریافت مقاله ۹۰/۱۱/۱۲ و تاریخ پذیرش آن ۹۱/۶/۱۳ می‌باشد.

(۱) نویسنده‌ی مسؤول: دانشجوی دکتری، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

(۲) دانشیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

(۳) استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند.

مقدمه

هندسه‌ی ریزمجرا در ریز مخلوطگرهای لایه‌ای (Lamination micromixer) نیز به کار گرفته می‌شود که در آن‌ها با تفکیک و تلفیق لایه‌های جریان سیال، طول پخش مولکولی کاهش می‌یابد [8]. اختلاط لایه‌ای بیشتر تحت تأثیر نحوه ترکیب اجزا در ورودی ریزمجرا می‌باشد [9]. توسط این مکانیزم اختلاط می‌توان به بزرگ‌نمایی هیدرودینامیکی (Hydrodynamic focusing) بیشتری دست یافت [10] که قابل استفاده در جریان‌های الکترواسموتیک می‌باشد [11]. مخلوطگرهای لایه‌ای سازگار با جریان‌های فشار-محرك نیز طراحی شده‌اند که در هر گذر سیال از آنها، طول پخش مولکولی نصف می‌گردد [12]. اختلاط آشوبناک در جریان‌های دو بعدی گذرا و یا سه بعدی رخ می‌دهد. علاوه بر موارد ذکر شده، ایجاد شیارهای سطحی [13] و تنظیم جهت‌گیری مناسب آن‌ها نسبت به امتداد جریان [9-14] می‌تواند آب‌گریزی سطوح کanal را افزایش دهد و باعث ایجاد سرعت‌های عرضی در مجاورت دیواره و تشکیل جابه‌جایی آشوبناک شود. یک روش مشابه دیگر، ایجاد دندانهای سطحی روی دیواره ریزمجرا است [15] که باعث افزایش اختلاط می‌شود.

مطالعات متعدد در زمینه‌ی الکتروکیتیک نشان داده است که خواص سطحی دیواره ریزمجرا می‌تواند باعث ایجاد الگوهای پیچیده‌ی جریان گردد. بررسی ریزمجراهای با زتاپتانسیل غیریکنواخت به صورت عددی [16-18] و تحلیلی [19-21] نشان می‌دهد که ناهمگنی خواص سطحی منجر به ایجاد جریان‌های پیچیده و چرخشی می‌شود که با شکستن خطوط چرخشی بسته‌ی این جریان‌ها می‌توان از مزایای پخش آشوبناک بهره برد. برای دست‌یابی به پخش آشوبناک بایستی جریان دو بعدی گذرا [22,23] و یا سه بعدی دائمی [24] داشت. در چنین حالاتی، حل میدان سرعت درون ریزمجراهای با دیواره ناهمگن

در دهه‌ی گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه‌ی سیستم‌های تحلیل‌گر تمام‌آریز (Micro total analysis system) و یا وسایلی نظری تراشه‌های آزمایشگاهی (Lab-on-a-Chip) انجام شده است و کاربردهای متنوعی از آن‌ها در فرآیندهای بیولوژیک و بیوشیمی معرفی شده است. در بسیاری از این کاربردها اختلاط مناسب گونه‌ها اهمیت بالایی دارد. غالباً رژیم جریان درون ریزمجراهای مستقیم و یا حتی دارای انحنای [1] در محدوده‌ی آرام و خطوط جریان موازی و متقارن است. در نتیجه اختلاط فقط توسط پخش مولکولی انجام می‌شود که ذاتاً فرآیندی کند است. با افزایش عدد رینولدز ($Re=10$) امکان ایجاد جریان‌های نامتقارن و بهبود اختلاط وجود دارد [2] اما به لحاظ جنبه‌های عملی چندان موجه نیست. برای افزایش میزان اختلاط روش‌های مختلفی مبتنی بر مکانیزم‌های فعال و یا غیرفعال پیشنهاد شده است [3]. با اختلاط فعال می‌توان به راندمان‌های بالاتر برای اختلاط دست یافت اما این روش در برخی کاربردها بهویژه تراشه‌های آزمایشگاهی مطلوب نیست و حتی ممکن است استفاده از این روش روی نمونه‌های بیولوژیکی اثرات منفی داشته باشد [4].

از طرف دیگر، در اختلاط غیر فعال سعی می‌شود تا پخش مولکولی با استفاده از تکنیک‌های مختلف تقویت گردد. یکی از این روش‌ها ایجاد جابه‌جایی آشوبهای (Chaotic advection) است که با افزایش سطح تماس بین گونه‌های مورد اختلاط و ایجاد جریان‌های ثانویه و عرضی باعث دستکاری در طرح جریان آرام حاکم بر ریزمجرا می‌شود و پیرو آن با کاهش طول پخش مولکولی، اختلاط بهبود می‌یابد. شیوه‌های مختلفی برای ایجاد اختلاط غیرفعال وجود دارد. بارزترین این شیوه‌ها ایجاد غیریکنواختی در هندسه‌ی ریزمجرا است [5-7]. تغییر

نوسانی باشد [34]. برای ارزیابی اختلاط، استفاده از یک معیار مناسب ضروری می‌باشد. در جریان‌های ساده و یکراهم استفاده از انحراف معیار غلظت‌ها نسبتاً رایج است و نتایج مطلوبی دارد [9, 5, 7, 9]. استفاده از آنتروپی مربوط به اختلاط نیز می‌تواند به عنوان معیار اختلاط در نظر گرفته شود [15, 35, 36]. در جریان‌های پیچیده‌ی شامل گردابه، معیارهای مبتنی بر غلظت دچار مشکلاتی هستند به این صورت که در نواحی نزدیک گردابه میزان اختلاط را بدستی ارزیابی نمی‌کنند و نوسانات غیر فیزیکی را در مقدار راندمان اختلاط پیش‌بینی می‌کنند [16, 23, 35, 37, 38]. از این‌رو با استی معیاری برای اختلاط استفاده شود که در آن اثرات چرخش سیال بر اختلاط در نظر گرفته شود. این کار با اعمال تابع وزن سرعت می‌تواند انجام شود و این معیار می‌تواند به خوبی میزان اختلاط در جریان‌های پیچیده و سه‌بعدی را تحلیل نماید.

در مطالعات موجود، تحلیل سه‌بعدی ریزمخلوط‌گرها کمتر انجام شده است و مطالعات انجام‌شده غالباً به صورت موردنی است، به گونه‌ای که امکان مقایسه یافته‌ها برای سایر محققان راحت نیست. در این بررسی‌ها معیارهای مختلفی برای تعیین راندمان اختلاط استفاده شده است و حتی نتایج به دست آمده ابهاماتی داشته‌اند. در این مقاله اختلاط ناشی از اثرات الکتروکیتیکی درون ریزمجراهای ناهمگن با استفاده از مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی به صورت سه‌بعدی مطالعه شده است. برای دست‌یابی به اختلاط مناسب چند ریزمخلوط‌گر با سطوح ناهمگن مختلف معرفی شده است و معیار مناسبی برای اختلاط تبیین شده است که می‌تواند در جریان‌های دارای گردابه به خوبی اختلاط را ارزیابی کند. به علاوه الگوهای دیواره به نحوی مورد معرفی قرار گرفته‌اند که مطالعه‌ی آن‌ها منجر به شناسایی پارامترهای مهم در اختلاط می‌شود و نتایج به دست آمده را می‌توان به صورت مدون ارائه کرد.

نیازمند حل همزمان میدان الکتریکی و توزیع بار و معادله‌های ناویر-استوکس می‌باشد که به لحاظ عددی پرهزینه است و مطالعات نسبتاً محدودی در این زمینه وجود دارد [25, 26]. غالباً از روش‌های اقتصادی‌تر برای حل این مجموعه معادلات استفاده می‌شود که در آن‌ها فقط در مجاورت دیواره‌ها معادلات به صورت کامل حل می‌شوند [27]. یک ساده‌سازی نسبتاً رایج برای جریان‌های ساده با رینولدزهای کم و لایه‌ی دوگانه‌ی الکتریکی (Electric Double Layer) نسبتاً کوچک این است که خطوط میدان جریان الکترواسموتیک و میدان الکتریکی در همه‌جا متشابه در نظر گرفته شوند. شرایط لازم برای این تشابه توسط محققان تبیین شده است [28, 29]. یک حالت مهم از این تشابه به معادله‌ی هلمهولتز-اسمولوکوفسکی متنهی می‌شود و بر این اساس همه‌ی اثرات الکتروکیتیکی بر میدان جریان به صورت نوعی شرط لغزش در مرز جریان داخل ریزمجراء با لایه‌ی دوگانه‌ی الکتریکی در نظر گرفته می‌شود و با استفاده از این شرط مرزی، میدان سرعت درون حوزه‌ی جریان حل می‌شود. پیشرفت فن‌آوری در سال‌های اخیر باعث شده است تا ایجاد ناهمگنی‌های مختلف در خواص سطحی ریزمجراء [30, 31] و یا حتی کنترل زمانی و مکانی زتاپنسیل [32] در نواحی ناهمگن صورت پذیرد. با طراحی مناسب این ناهمگنی‌ها در جریان‌های فشار-محرك می‌توان ریزمجراهایی را معرفی کرد که برای مقاصد اختلاط، پمپاژ و یا هر دوی آن‌ها قابل استفاده باشد [33]. توسط روش‌های عددی اثر اندازه‌ی ناهمگنی و شدت ناهمگنی (یعنی اختلاف بین زتاپنسیل بخش‌های همگن و ناهمگن) راندمان اختلاط درون چنین ریزمجراهایی مورد بررسی قرار گرفته است [21, 24] و عملکرد این شیوه در محفظه‌های اختلاط مطالعه شده است [23]. علاوه بر ناهمگنی‌ها اثرات میدان اعمالی نیز می‌تواند بر راندمان اختلاط مؤثر باشد به خصوص اگر میدان الکتریکی

ریز مخلوطگر را تشکیل می‌دهد، دو جفت تکه ناهمگنی روی دو دیواره‌ی موازی ریز مجرای قرار گرفته‌اند. اندازه‌ی زتاپتансیل برای همه‌ی تکه‌های ناهمگنی برابر با 50 mV است اما علامت بار آنها می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به عنوان مثال در شکل (۱) فقط دیواره‌های جانبی دارای زتاپتансیل مخالف صفر هستند. در این شکل زتاپتансیل مثبت با رنگ تیره و زتاپتансیل منفی با رنگ روشن نشان داده شده است. معادله‌ی حاکم بر این جریان الکترواسموتیک توسط معادله‌ی ناویر-استوکس بیان می‌شود:

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\nabla} \ddot{\mathbf{u}} = -\vec{\mathbf{v}} p + \mu \nabla^2 \ddot{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{F}}_e \quad (1)$$

که در آن $\ddot{\mathbf{u}}$ بردار سرعت و $\vec{\mathbf{F}}_e$ نیروی الکتریکی ناشی از میدان الکتریکی می‌باشند. معادله (۱) به همراه معادله پیوستگی، توزیع سرعت و فشار را در سیال مشخص می‌کند. در ورودی و خروجی ریز مجرای $\partial \ddot{\mathbf{u}} / \partial x = 0$ می‌باشد. سایر شرایط مرزی برای سرعت با توجه به مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی تعیین می‌شوند. در این مدل اثر اعمال میدان الکتریکی \vec{E} روی بارهای مجاور دیواره (لایه‌ی دوگانه‌ی الکتریکی) به صورت نوعی شرط مرزی لغزشی در نظر گرفته می‌شود و در مقابل جمله‌ی مربوط به نیروی الکتریکی \vec{F}_e از معادله‌ی ناویر-استوکس حذف می‌شود. این سرعت لغزشی به موازات دیواره‌های ریز مجرای و در امتداد میدان الکتریکی است. به عنوان نمونه برای دیواره‌ی پایینی ($y=0$) و دیواره‌ی جلویی ($z=W$) شرایط مرزی به ترتیب توسط روابط (۲) و (۳) مشخص می‌شود.

$$\begin{aligned} y=0 : u &= -\epsilon E_x \zeta_{bottom}(x) / \mu \\ v &= 0 \\ w &= -\epsilon E_z \zeta_{bottom}(x) / \mu \end{aligned} \quad (2)$$

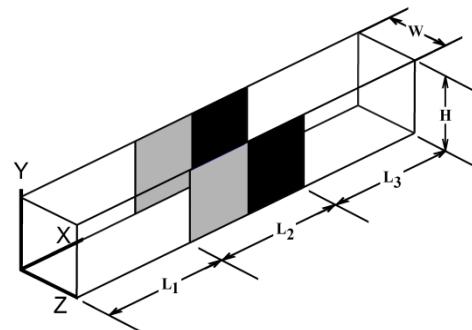
$$\begin{aligned} z=W : u &= -\epsilon E_x \zeta_{front}(x) / \mu \\ v &= -\epsilon E_y \zeta_{front}(x) / \mu \\ w &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

برای دیواره‌های بالا و عقب نیز روابط مشابهی نوشته می‌شود. طبق معادله‌ی (۲) سرعت لغزشی

با توجه به میدان جریان و وضعیت گردابه‌ها نسبت به دو سیال مورد اختلاط، برخی شاخصه‌های مؤثر جریان بر اختلاط پیشنهاد شده‌اند به نحوی که با کمک این شاخصه‌ها می‌توان حتی بدون داشتن میدان اختلاط، به خوبی رتبه‌ی اختلاطی میدان جریان را ارزیابی کرد. علاوه بر این موارد، در این مقاله مفاهیم مناسبی برای مطالعه‌ی اختلاط مانند راندمان اختلاطی ریز مجرای و ظرفیت اختلاطی معرفی شده است که می‌تواند مشخصه‌های اختلاط را بهتر معرفی کند.

مدل‌سازی جریان الکترواسموتیک

شکل (۱) جزئیات مربوط به ریز مجرای ناهمگن به ارتفاع H ، عرض $W=H$ و طول $L=6H$ را نشان می‌دهد که درون یک میدان الکتریکی خارجی به قدرت یکنواخت E قرار دارد. اثر میدان الکتریکی روی لایه دوگانه الکتریکی تشکیل شده در مجاورت دیواره‌ها می‌تواند منجر به جریان الکترواسموتیک درون ریز مجرای مورد نظر به اهداف مورد نظر در این مقاله، ریز مجرای مورد نظر به سه قسمت ابتدایی، میانی و انتهایی به ترتیب با طول‌های $L_1=2H$ ، $L_2=2H$ و $L_3=2H$ تقسیم شده است.



شکل ۱ مشخصات ریز مجرای مورد بررسی در صفحات ناهمگنی بار و محورهای مختصات

در قسمت‌های ابتدایی و انتهایی دیواره‌ی ریز مجرای بدون بار است و در قسمت میانی که بخش

جريان شطرنجی به عنوان حل شناخته نشوند. با این حال استفاده از شبکه‌ی جایه‌جا شده فضای لازم برای ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به هندسه‌ی جریان افزایش می‌یابد به‌نحوی که در برخی موارد حجم محاسبات مورد نیاز باعث محدودیت در کدنویسی می‌گردد.

در این مقاله از روش حجم کترل به‌همراه یک شبکه‌ی هم‌مکان استفاده شده است. چنین کاری ممکن است باعث بروز نوسانات غیر فیزیکی در جواب‌های میدان جریان شود. برای رفع این مشکل مقدار سرعت روی وجوه حجم کترلی توسط میان‌یابی رای-چو [39] محاسبه شده است. به عنوان نمونه برای تعیین مقدار سرعت روی وجه شرقی ابتدا سرعت‌های اصلاحی در موضع مرکز حجم کترل (\hat{u}_P) و سرعت اصلاحی در وجه شرقی (\hat{u}_E) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned}\hat{u}_P &= u_P - \frac{(P_e - P_w)}{|we|(a_p)_P} \delta \forall \\ \hat{u}_E &= u_E - \frac{(P_{ee} - P_e)}{|e(ee)|(a_p)_E} \delta \forall\end{aligned}\quad (7)$$

در رابطه فوق زیرنویس‌های با حروف کوچک (e, ee, w) مربوط به محل وجوه حجم‌های کترلی و زیرنویس‌های با حروف بزرگ (E, P) مربوط به مرکز حجم‌های کترلی هستند. بنابراین e معرف وجه شرقی، w معرف وجه غربی و ee معرف وجه شرقی از المان همسایه (در سمت شرق) است. طول پاره خط از نقطه‌ی e تا نقطه w است. مقادیر فشارها روی وجهه مانند P_e ، P_w و P_{ee} توسط میان‌یابی خطی به دست می‌آیند. سپس مقدار سرعت روی وجه شرقی (\hat{u}_e) بر حسب سرعت‌های اصلاحی و گرادیان فشار مربوطه محاسبه می‌شود:

$$u_e = (f_x)_P \hat{u}_E + (1 - (f_x)_P) \hat{u}_P + \frac{(P_E - P_P)}{|PE|(a_p)_e} \delta \forall \quad (8)$$

اعمال شده روی دیواره‌ها به ϵ ثابت دی‌الکتریک سیال، میزان قدرت میدان الکتریکی اعمال شده در امتداد دیواره‌ی ریزم جدا و به مقدار زتاپتانسیل دیواره (ζ) بستگی دارد. به عنوان مثال چنان‌چه زتاپتانسیل دیواره منفی باشد با یک مقدار مثبت ϵ_E (از ζ به راست) جهت سرعت لغزشی به وجود آمده مثبت و به سمت راست است. مقدار ϵ از رابطه $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ به دست می‌آید که در آن ϵ ثابت دی‌الکتریک نسبی سیال (نسبت به خلاء) و $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C/Vm}$ ثابت دی‌الکتریک خلا است.

در بررسی عملکرد اختلاطی ریزمجراهای میدان غلطت توسط حل معادله (4) به دست می‌آید.

$$\rho \vec{u} \cdot \vec{\nabla} C = D \nabla^2 C \quad (4)$$

که در آن D ضریب پخش مولکولی و C غاظت گونه‌های مورد نظر است. شرایط مرزی مربوط به یک گونه با دو غلطت متفاوت در ورودی ریزمجرای به صورت زیر اعمال می‌شود:

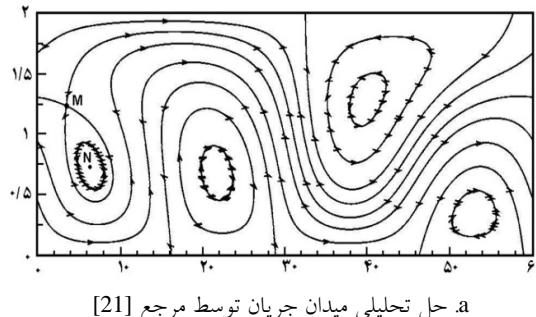
$$C(0, y, z) = \begin{cases} 0, & 0 < y < 0.5H \\ 1, & 0.5H < y < H \end{cases} \quad (5)$$

به علاوه، روی دیواره‌ها و در خروجی ریزمجرای گرادیان غلطت در جهت عمود بر مرز صفر لحاظ شده است:

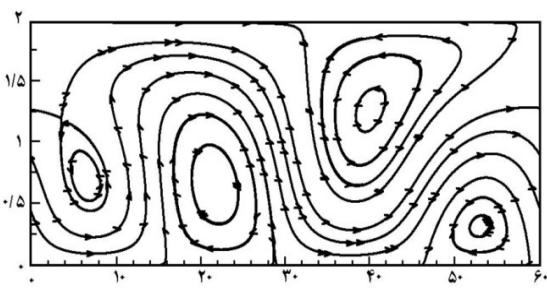
$$\begin{aligned}\frac{\partial C(x, 0, z)}{\partial y} &= 0 & \frac{\partial C(x, H, z)}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial C(x, y, 0)}{\partial z} &= 0 & \frac{\partial C(x, y, W)}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial C(L, y, z)}{\partial x} &= 0\end{aligned}\quad (6)$$

روش عددی و گسترش‌سازی معادلات. مرسوم است که برای حل عددی معادلات جریان از روش حجم محدود با متغیرهای جایه‌جا شده استفاده شود. این کار باعث می‌شود تا میدان‌های جریان نادرست مانند میدان

آمده است. برای این میدان جریان پیچیده، حداقل خطای نسبی موجود در پیش‌بینی مکان نقاط تکین در جهت عرضی (جهت y) برابر با $\Delta y/H = 0.01$ و در جهت طولی برابر با $\Delta x/L = 0.001$ است که نشان از دقت قابل قبول نتایج عددی در مقایسه با نتایج تحلیلی دارد.



a. حل تحلیلی میدان جریان توسط مرجع [21]



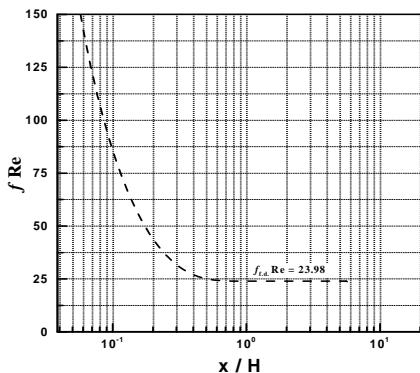
b. حل عددی میدان جریان

شکل ۲ مقایسه‌ی حل عددی و تحلیلی میدان جریان

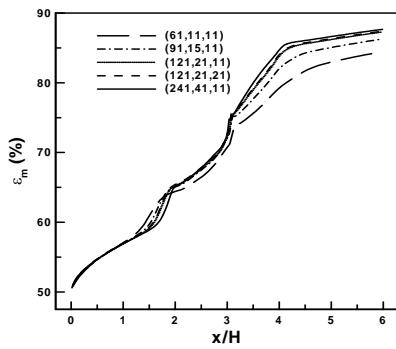
استقلال از گره. در شکل (۳) نتایج مربوط به راندمان اختلاط در طول ریز‌ مجرفا که توسط شبکه‌های محاسباتی مختلف به دست آمده، با یکدیگر مقایسه شده است. بر مبنای مقدار محاسبه شده‌ی راندمان در انتهای ریز‌ مجرفا و با در نظر گرفتن دقت مناسب و بهینه شدن حجم محاسبات، شبکه‌ی محاسباتی $21 \times 21 \times 121$ مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه بالا f_x ضریب شکل است. پس از محاسبه‌ی سرعت‌ها روی وجهه حجم‌های کنترل، مقدار کمیت‌ها روی وجهه توسط طرح هیریدی محاسبه می‌شود و سپس مقدار شار کمیت روی وجهه محاسبه می‌شود. جملات مربوط به پخش توسط طرح تفاضل مرکزی محاسبه می‌شوند. جهت ارتباط دادن میدان سرعت و فشار بایستی طرح مناسبی انتخاب شود. مرحله‌ی اساسی در روش‌های فشار مبنا ارتباط دادن مقادیر سرعت اصلاحی به فشار اصلاحی است. نحوه‌ی این ارتباط منشأ روش‌های مختلفی از جمله روش‌های خانواده SIMPLE است. در این مقاله از روش SIMPLEC استفاده شده است. در این روش می‌توان نشان داد که ارتباط مقادیر اصلاحی برای سرعت‌ها با مقادیر اصلاحی برای فشار در هر مرحله به صورت $d_p \nabla P' = -\Delta \nabla / a_p \delta x$ است که $d_p = -\Delta \nabla / a_p \delta x$ است. جریان‌هایی که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است دارای الگوهای پیچیده به همراه گردابه هستند. بررسی‌های عددی نشان داد که برای حل میدان جریان در چنین مواردی استفاده از شبکه‌ی یکنواخت به ترین نتایج را برای حل جریان دارد چون با توجه به پیچیدگی‌های جریان و گردابه‌های موجود اعمال ضریب انبساط (یا انقباض) در برخی موارد منجر به واگرایی حل می‌شود.

اعتبارسنجی حل عددی. برای اطمینان از صحت حل عددی نتایج مربوط به میدان جریان عددی با نتایج حل تحلیلی [19] در حالت‌های مختلف مقایسه شده است و برای یک جریان پیچیده میدان‌های مربوط در شکل‌های (۲a) و (۲b) نشان داده شده‌اند. موقعیت مرکز گردابه که در شکل (۲a) یا نقطه‌ی N نشان داده شده است و موقعیت نقطه‌ی M در شکل (۲a) یا نقطه‌ی (x,y)_N = (6.50, 0.75) محاسبه شده است و موقعیت نقطه‌ی (x,y)_M = (3.70, 1.22) به دست آمده است. با توجه به شکل (۲b) موقعیت این نقاط توسط حل عددی برابر



شکل ۵ نمودار ضریب اصطکاک به دست آمده توسط حل عددی برای جریان بین دو صفحه‌ی موازی



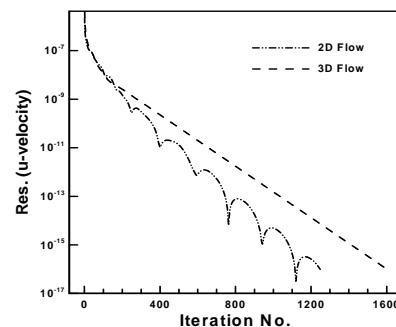
شکل ۳ بررسی استقلال از گره نتایج برای راندمان اختلاط

نتایج

نتایج این مقاله برای جریانی از یک الکتروولیت با ثابت دی الکتریک نسبی $\epsilon_r = 78.5$, چگالی $\rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$ و لزجت $\mu = 1.025 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$ درون ریزمجرای سه بعدی با ارتفاع $H = 5 \mu\text{m}$, عمق $W = 5 \mu\text{m}$ و $\zeta = 50 \text{ mV}$ انجام شده است. قدرت میدان الکتریکی خارجی است در حالی که اختلاف فشار معینی $E = 29.5 \text{ V/mm}$ باعث حرکت سیال می‌شود. تحت این شرایط برای یک ریزمجرای دوبعدی همگن، یعنی ریزمجرایی که در تمامی دیواره‌های آن مقدار زتاپتانسیل برابر با $\zeta = 50 \text{ mV}$ باشد، میزان سرعت لغزشی ایجاد شده در مجاورت دیواره‌ها به خاطر اثر میدان بر بارهای الکتریکی مجاور دیواره برابر با $u_s = 1 \text{ mm/s}$ است. بر مبنای این سرعت لغزشی عدد رینولذز برابر با $Re = 0.0049$ محاسبه می‌شود. در این حالت رژیم جریان الکترواسموتیک در محدوده آرام است و اختلاط گونه‌ها غالباً مبتنی بر پدیده‌ی پخش مولکولی است، لذا راندمان اختلاط پایین می‌باشد. اما مشاهده شد که چنان‌چه فقط بخش‌های محدودی از دیواره‌ی ریزمgra دارای زتاپتانسیل باشد و سایر مناطق بدون بار

برای اطمینان از نمودار همگرایی برای مؤلفه‌ی سرعت محوری (u ، میدان جریان دوبعدی و سه بعدی در شکل ۴) نشان داده شده است. باقیمانده‌ی سرعت توسط یک سرعت مرجع به صورت نسبی محاسبه شده است تا مقدار آن‌ها مستقل از یکای مربوط باشد. معادلات حاکم تا زمانی حل شده‌اند که باقیمانده حداکثر در بین تمام معادلات از مقدار 10^{-16} کمتر باشد.

برای اطمینان از درستی حل عددی، ضریب اصطکاک برای جریان بین دو صفحه‌ی موازی توسط کد عددی محاسبه شده است و نمودار آن در شکل ۵ نمایش داده شده است. در حالت جریان توسعه‌یافته بین دو صفحه‌ی موازی مقدار $f_{f,d}, Re = 24$ توسط کد عددی برابر با $(f_{f,d}, Re)_{\text{Num.}} = 23.98$ به دست آمده است.

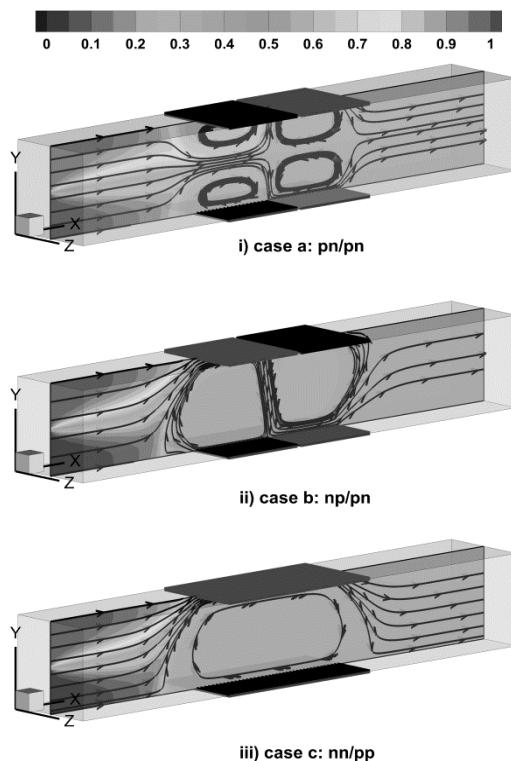


شکل ۴ بررسی همگرایی حل عددی در حالت دوبعدی و سه بعدی

قطعه‌ی دیگر بار منفی دارد. مقدار قدر مطلق زتاپتансیل در تمامی این چهار قطعه برابر با $mV = 50$ است. بسته به مقدار بار، نوع بار و نحوه آرایش مکانی قطعات باردار مثبت و منفی، مقدار و جهت سرعت لغزشی در مجاورت دیوارها متفاوت خواهد بود. برای مسئله مورد بررسی ما که مقدار بارهای قطعات با هم مساوی است، سه وضعیت متمایز برای آرایش بارها روی دو دیواره موازی بالایی و پایینی قابل تصور است. در شکل (۶) این سه وضعیت مختلف به همراه خطوط جریان ناشی از اثرات الکتروکیتیک برای اختلاف فشار $\Delta p = 0.01 \Delta p_{ref}$ نشان داده شده است. مقدار Δp_{ref} اختلاف فشار مرجع برابر $8Re\mu^2L/(\rho H^3)$ است. در این شکل بارهای مثبت روی دیوارهای با رنگ تیره و بارهای منفی با رنگ روشن نشان داده شده‌اند و کانتورهای غلظت در صفحه $z=0$ توسط گرادیان رنگ سیاه و سفید مشخص شده‌اند. در وضعیت (a) روی دیوارهای بالایی از چپ به راست ابتدا یک تکه ناهمگنی با بار مثبت (p) و سپس یک تکه ناهمگنی با بار منفی (n) قرار دارد و در دیوارهای پایینی همین وضعیت تکرار شده است. زمانی که اندازه بارها در این چهار تکه ناهمگنی برابر باشد، این وضعیت با نماد (pn/pn) مشخص می‌شود. دو آرایش متفاوت دیگر که با همین چهار تکه ناهمگنی شکل می‌گیرند عبارتند از (np/pn) و (nn/pp) و در شکل‌های (iii) و (iv) نشان داده شده‌اند. هنگامی که اندازه بارها متفاوت باشد، وضعیت‌های بیشتری قابل طراحی است اما در این مقاله فقط وضعیت‌های با بار مساوی مورد بررسی قرار گرفته است.

تمام وضعیت‌های نشان داده شده در شکل (۶) برای کanal دو بعدی و سه بعدی مشترک هستند. در این وضعیت‌ها میدان الکتریکی خارجی در امتداد ریز مجررا و به موازات سطوح جانبی اعمال شده است. در یک کanal دو بعدی فقط یک جفت دیواره موازی و در کanal سه بعدی، دو جفت دیواره موازی برای تعییه

باشد، مقدار راندمان اختلاط به شدت افزایش خواهد یافت. ازین‌رو، مطالعه و معرفی ریز مجراهای ناهمگن که اختلاط بهینه داشته باشند، اهمیت فراوانی دارد.



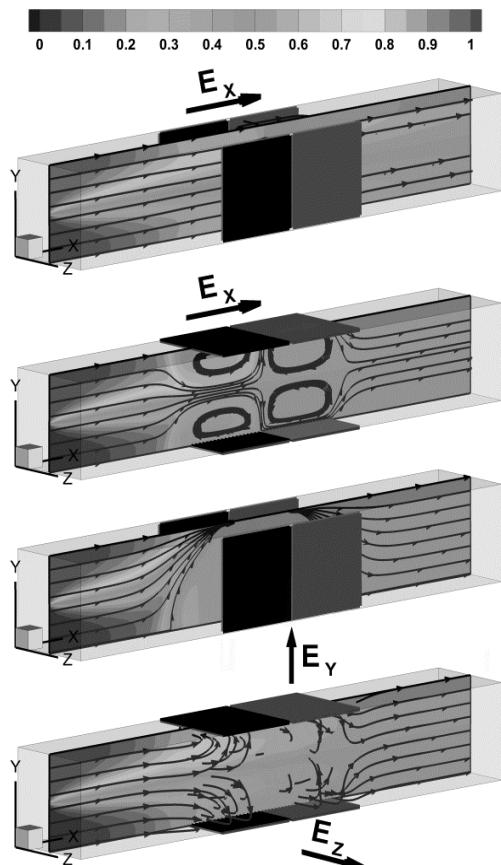
شکل ۶ الگوهای جریان و کانتورهای غلظت برای جریان مرکب الکترواسموتیک و فشار-محرك در صفحه میانی درون ریز مجرای سه‌بعدی با E مثبت از چپ به راست و اختلاف فشار $\Delta p = 0.01 \Delta p_{ref}$

برای بررسی عملکرد اختلاطی ریز مجراهای ناهمگن سه نوع ریز مخلوطگر با یک E ثابت و مثبت (در جهت محور مختصات) معرفی شده است که در همه‌ی آن‌ها، دیوارهای در قسمت ورودی و خروجی ریز مجرای بدون بار و در قسمت میانی که نقش مخلوطگر الکترواسموتیکی را دارد، دارای بار منفی یا مثبت هستند. در قسمت میانی روی دیوارهای متقابله، قسمت ناهمگن تعییه شده است. برای ایجاد قسمت ناهمگن از چهار قطعه‌ی ناهمگنی با طول‌های مساوی استفاده شده است که دو قطعه‌ی آن‌ها بار مثبت و دو

(از چپ به راست)، مقادیر سرعت‌های لغزشی مجاور دیوار در قسمت میانی ریز مجرای شکل (۶a) برابر است با:

$$u^t(x) = u^b(x) = \begin{cases} u_p = -1 \frac{\text{mm}}{\text{s}}, & 3 < x/H < 4 \\ u_n = +1 \frac{\text{mm}}{\text{s}}, & 4 < x/H < 5 \end{cases} \quad (9)$$

که در آن زیرنویس‌های p یا n برای سرعت u معرف بار مثبت یا منفی قطعات است. به این معنا که با یک E مثبت، سرعت لغزشی در مجاورت دیواره با بار زتاب‌پتانسیل منفی (n) همواره $+1 \text{ mm/s}$ است و بالعکس.

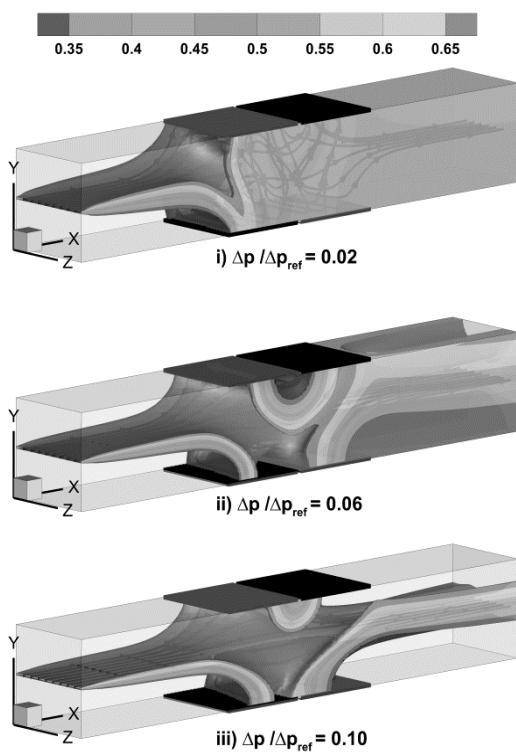


شکل ۷ وضعیت‌های متفاوت ناهمگنی روی دیواره ریز مجرای سه‌بعدی و میدان جریان و غلظت مربوط با توجه به جهت میدان خارجی و نحوه ورود دو سیال در ورودی ریز مجرای (ترکیب جریان الکترواسموتیک و فشار-محرك با $\Delta p = 0.01 \Delta p_{\text{ref}}$)

قطعات ناهمگنی وجود دارد. از طرفی در هندسه دو بعدی میدان الکتریکی فقط می‌تواند در جهت طولی اعمال شود در حالی که برای هندسه سه‌بعدی این امکان وجود دارد که میدان الکتریکی خارجی در هر کدام از سه جهت دستگاه مختصات اعمال شود. با توجه به این ملاحظات در ریز مجراهای سه‌بعدی آرایش بارها می‌تواند بسیار متنوع‌تر باشد. در یک ریز مجرای سه‌بعدی به همراه دو جفت قطعه ناهمگنی با بار یکسان اما مخالف، با توجه به نحوه ورود دو جریان ورودی، چیدمان قطعات بر دیوارهای مقابل می‌تواند به ۱۲ صورت انجام شود. به این معنی که هر کدام از وضعیت‌های قابل اجرا در کanal دو بعدی (یعنی وضعیت‌های a, b و c از شکل (۶)) در هندسه سه‌بعدی می‌تواند دارای چهار حالت متمایز باشد. برای درک این مطلب، چهار حالت مربوط به وضعیت (a) از شکل (۶) به همراه میدان جریان و غلظت در شکل (۷) نشان داده شده است. مشابه با شکل (۶) بارهای مثبت روی دیوارهای با رنگ تیره، بارهای منفی با رنگ روشن و کانتورهای غلظت در صفحه $z=0$ توسط گرادیان رنگ سیاه و سفید مشخص شده‌اند. برای سهولت در شناسایی این آرایش‌ها، آن‌ها را به صورت نمادین نام‌گذاری می‌کنیم. بدین صورت که نوع الگوی ناهمگنی، محورهای مربوط به صفحه ناهمگنی و جهت میدان را با حروف اختصاری مشخص می‌نماییم. به عنوان مثال برای حالت اول از شکل (۷) الگوی بارهای ناهمگنی روی صفحات به صورت (pn/pn) است و این ناهمگنی‌ها در صفحات با محورهای مختصات x-y قرار دارند و جهت میدان الکتریکی اعمالی در جهت x است. این حالت به صورت $(pn/pn, Ex)$ معروفی می‌شود. با استفاده از این قرارداد سایر حالات شکل (۷) عبارتند از: $(pn/pn, x-z, Ez)$, $(pn/pn, x-y, Ey)$ و $(pn/pn, x-z, Ez)$.

مطابق رابطه‌ی (۲)، با توجه به جهت مثبت E

نسبتاً مخلوط شده و وسعت کمتری دارد بهنحوی که برای حالت $\Delta p = 0.10 \Delta p_{ref}$ فقط یک لایه‌ی نازک در مجاورت فصل مشترک دوگونه‌ی مورد اختلاط نسبتاً مخلوط شده‌اند. به منظور بررسی کمی و دقیق این موضوع، بایستی راندمان اختلاط به صورت مناسبی تعریف شود.



شکل ۸ اثر میدان فشار خارجی بر جریان و نحوه‌ی اختلاط درون ریز مجرای سه‌بعدی

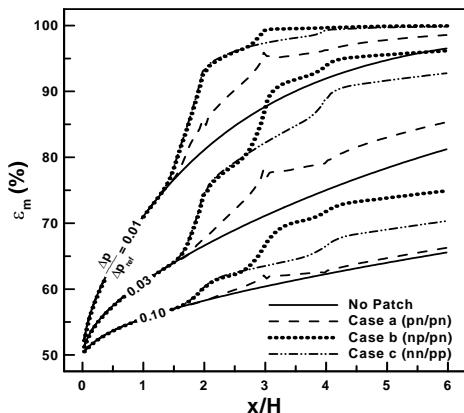
راندمان اختلاط. با توجه به مطالب گفته شده، راندمان اختلاط بر مبنای میانگین وزن‌دار انحراف از معیار غلظت (ϵ_w) بهنحوی تعریف می‌شود تا در جریان‌های دارای گردابه میزان اختلاط را به درستی نشان دهد. راندمان اختلاط (ϵ_m) در هر مقطع عرضی از یک ریز مجرای به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\epsilon_m = \frac{1 - \sigma_w}{1 - \sigma_{w, min}} \quad (10)$$

با توجه به این که بار الکتریکی دیواره‌ها در قسمت ورودی و خروجی برابر با صفر است، تولید سرعت لغزشی در این نواحی بی‌بار صفر است. با این وجود سیال می‌تواند بنا به دلایل ثانویه در این نواحی نیز حرکت داشته باشد. سه نوع آرایش a, b, c برای بارهای قسمت میانی را می‌توان بر حسب علامت‌های ϵ_p و ϵ_w نیز بیان نمود. توجه شود که در جریان‌های نشان داده شده در شکل (۷ و ۸) همه‌ی دبی‌های عبوری از ریز مجرای به دلیل اعمال میدان فشار خارجی است و جریان الکترواسموتیک هیچ دبی خالصی تولید نمی‌کند. در حقیقت در یک جریان الکترواسموتیک خالص تا زمانی که مقدار متوسط سرعت لغزشی در دیواره‌ها برابر با صفر باشد، مقدار دبی عبوری برابر با صفر خواهد بود.

در شکل (۸) اثر میدان فشار خارجی روی میدان جریان و غلظت نشان داده شده است. برای این که نحوه‌ی اختلاط و حوزه‌ی مؤثر آن بهتر معلوم شود، فقط آن نواحی از میدان جریان نمایش داده شده است که در آن‌ها مقدار غلظت بین 0.3 تا 0.7 است. با توجه به این که مقدار نهایی غلظت پس از اختلاط کامل برابر با 0.5 است، این دامنه غلظت هر چند که از اختلاط کامل فاصله دارد اما می‌تواند به صورت کیفی سیالی که غلظت آن در این محدوده است نسبتاً مخلوط شده در نظر گرفته شود. واضح است که هر چه وسعت این حوزه بیشتر باشد اختلاط مؤثرتر بوده است. با توجه به شکل (۸) به لحاظ کیفی می‌توان دید که در اختلاف فشارهای اندک اثر اختلاطی جریان کاملاً قابل توجه است و مقدار غلظت در بخش وسیعی از حوزه‌ی جریان بین 0.3 تا 0.7 است. برای $\Delta p = 0.02 \Delta p_{ref}$ مشاهده می‌شود که تقریباً همه‌ی حوزه‌ی جریان پس از رسیدن به ناحیه‌ی میانی نسبتاً مخلوط شده است. در اثر افزایش افت فشار با این که دبی جریان افزایش می‌یابد اما عملکرد اختلاطی ریز مجرای تضعیف می‌شود چون در این حالت حوزه

مشاهده می‌شود، در تمام موارد با پیش روی جریان در طول ریز مجرای راندمان اختلاط بیشتر می‌شود. در وضعیت دیوارهای بدون بار (No Patch) با افزایش اختلاف فشار و به تبع آن سرعت جریان، راندمان اختلاط در هر مقطع کاهش می‌یابد. این موضوع درست است چرا که با افزایش سرعت فرصت لازم برای اختلاط کاهش می‌یابد. وجود قسمت میانی با آرایش بار ناهمگن باعث افزایش قابل توجه عملکرد اختلاط شده است.



شکل ۹ راندمان اختلاط در طول ریز مجرای اختلاف فشارهای مختلف و الگوهای متفاوت ناهمگنی روی صفحات E_{x-z} به همراه

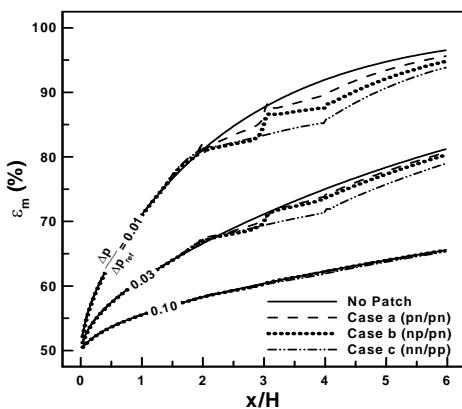
در هر یک از اختلاف فشارهای معین، تا قبل از رسیدن به قسمت میانی، عملکرد اختلاطی ریز مجرای بدون بار (یا حتی باردار یکنواخت) با ریز مجرای دارای بار ناهمگن کاملاً یکسان هستند اما در ناحیه‌ی میانی ریز مجرای با توزیع بار ناهمگن که سرعت‌های لغزشی دیواره، جریان‌های چرخشی قدرتمندی ایجاد می‌کنند، میزان اختلاط به نحو چشم‌گیری افزایش می‌یابد. با افزایش قدرت میدان فشار خارجی و تقویت جریان ناشی از آن، اثر گردابه‌های ناحیه میانی بر راندمان اختلاط کاهش می‌یابد. در هر سه حالت اختلاف فشار، برای سه آرایش بار نشان داده شده، آرایش بار دوم

که در آن $\sigma_{w,\min}$ یک مقدار مرجع است و در صورتی که اختلاط کامل به وجود آید، مقدار آن به حداقل خود یعنی صفر می‌رسد و مخرج کسر معادله (۱۰) برابر با ۱ می‌شود. به علاوه σ_w به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$[\sigma_w]^2 = \frac{\int_0^H u(y)(C(x,y) - C_m)^2 dy}{\int_0^H u(y) dy} \quad (11)$$

که در آن از توزیع عرضی سرعت $u(y)$ به عنوانتابع وزن‌دهنده در تعریف میانگین وزنی استفاده شده است. میزان غلظت در هر نقطه از میدان جریان و $C(x,y)$ مقدار متوسط آن در مقطع می‌باشد. اگر از رابطه‌ی (۱۳) برای ارزیابی راندمان اختلاط استفاده شود، آن‌گاه می‌توان عملکرد ریز مخلوطگرها را به‌طور کمی مقایسه نمود.

مطالعات نشان می‌دهد که در یک ریز مخلوطگر سه‌بعدی که قطعات ناهمگنی در دیواره‌ی بالا و پایین تعییه شده‌اند، با افزایش نسبت ارتفاع کانال به عمق آن میزان راندمان اختلاط بهبود می‌یابد. ریز مجرای دارای مطالعه در این تحقیق دارای عمق و ارتفاع مساوی هستند تا بتوان به درستی درباره‌ی اثر موقعیت قطعات ناهمگنی بر راندمان اختلاط اظهار نظر کرد و سایر اثرات مربوط به هندسه در راندمان اختلاط دخالت نداشته باشند. در شکل (۹) راندمان اختلاط برای سه اختلاف فشار و سه آرایش بار متفاوت (آرایش‌های a، b و c) با راندمان اختلاط در حالت دیوارهای بدون بار مقایسه شده است. همان‌طور که قبل اشاره شد، این آرایش‌ها می‌توانند روی زوج صفحات موازی چیده شوند. در این جا ناهمگنی‌های موردنظر روی صفحات بالایی و پایینی (صفحات x-z) قرار داده شده‌اند و میدان الکتریکی خارجی در جهت x اعمال شده است. بنابراین سرعت‌های لغزشی به وجود آمده در دیوارهای در امتداد محور x هستند. همان‌طور که



شکل ۱۰ راندمان اختلاط در طول ریزمجرابراي اختلاف فشارهای مختلف و الگوهای متفاوت ناهمنگی روی صفحات E_x به همراه $(x-y)$

در شکل (۱۰) دیده می‌شود که قرار دادن الگوهای ناهمنگی روی صفحات $x-y$ به همراه میدان الکتریکی در راستای x هیچ بهبودی در میزان اختلاط ایجاد نمی‌کند. در این حالت وجود ناهمنگی‌ها دارای اثرات منفی بر راندمان اختلاط می‌باشد و هر چه میزان میدان فشار اعمالی کمتر باشد، این اثرات منفی بیشترند. این گونه به نظر می‌رسد که جهت گیری گردابه‌ها نسبت به فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط دلیل این کاهش غیر عادی است. وجود گردابه در مسیر دو جریان مورد اختلاط منشأ دو اثر است. اول این که گردابه با داشتن خطوط بسته باعث می‌شود که ارتباط اختلاطی بین بخش درون و خارج گردابه فقط از طریق مکانیزم پخش مولکولی صورت گیرد و جایه‌جایی بین این دو ناحیه قطع شود. اثر دومی که گردابه روی جریان دارد این است که گردابه باعث تغییر مسیر خطوط جریان در ناحیه خارج از خود می‌شود و با کاهش سطح عبور جریان در جریان‌های داخلی باعث افزایش سرعت‌های جریان و اعوجاج خطوط جریان می‌گردد. بنابراین، اثر دوم منجر به بهبود اختلاط می‌گردد. در وضعیت مورد بررسی در شکل (۱۰) که ناهمنگی‌ها در صفحات $x-y$ قرار داند، هنگامی که میدان الکتریکی خارجی در

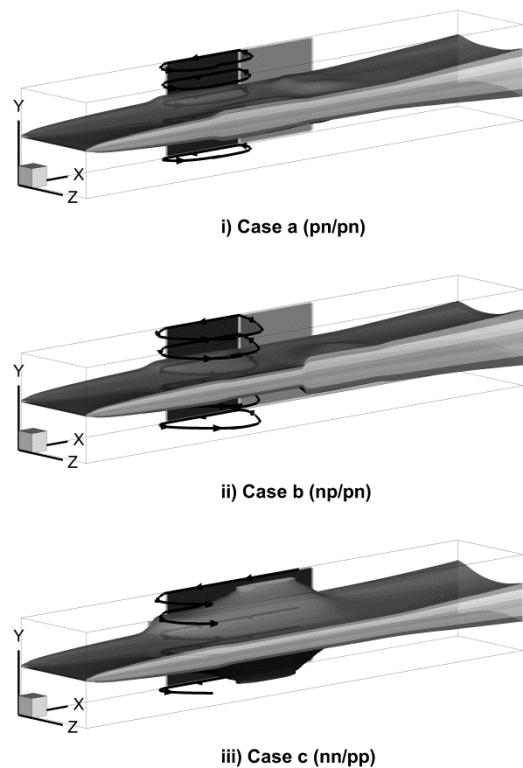
(np/pn) بیشترین راندمان اختلاط را دارا می‌باشد. در این وضعیت، آرایش تکه‌های ناهمنگی بار، کاملاً نامتقارن است. هر چه این عدم تقارن بیشتر باشد، میزان اختلاط افزایش می‌یابد. لذا بدترین عملکرد اختلاطی مربوط به آرایشی است که بیشترین تقارن را در الگوی بار دارد و بهترین عملکرد اختلاط مربوط به آرایشی است که کمترین تقارن را در الگوی بارها دارد. مشخصه‌ی نامتقارنی می‌تواند یک شاخص راهبردی در ارزیابی کیفی میزان اختلاط باشد.

نامتقارنی از دو جنبه قابل بحث است؛ جنبه اول میزان نامتقارنی در قسمت‌های ناهمنگی است که در شکل (۹) مورد مطالعه قرار گرفته شده است و دیده می‌شود که هر چه الگوی ناهمنگی‌ها نامتقارن‌تر باشد، میزان راندمان اختلاط بالاتر است. جنبه دوم نامتقارنی مربوط به نامتقارنی در وضعیت گردابه‌ها نسبت به صفحه فصل مشترک دو جریان مورد اختلاط است. میدان‌های جریان مربوط به شکل (۹) در نمودار (۶) نشان داده شده‌اند. مشاهده می‌شود که گردابه‌های به وجود آمده به صورت غالب در صفحه $x-y$ قرار دارند. این صفحه عمود بر صفحه فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط است و لذا گردابه‌ها باعث می‌شوند تا فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط از موضع خود جابه‌جا و دچار کشش و یا پیچش گردد. هر چه میزان این تغییر شکل‌ها بیشتر باشد، میزان اختلاط بیشتر بهبود می‌یابد. در شکل (۱۰) مجدداً همان آرایش‌های مربوط به شکل (۹) یعنی آرایش‌های a , b و c مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما با این تفاوت که صفحات جایگذاری آن‌ها تغییر کرده است و محل قرار دادن قطعات ناهمنگی در صفحات $x-y$ انتخاب شده است و میدان الکتریکی خارجی نیز در جهت x اعمال می‌شود. نتایج مربوط به راندمان اختلاط بسیار متفاوت با حالت پیشین است.

متمازی شده‌اند. مقادیر سرعت‌های لغزشی در ناحیه‌ی دارای بار مثبت برابر با $u = -0.001 \text{ m/s}$ ، در ناحیه‌ی دارای بار منفی برابر با $u = +0.001 \text{ m/s}$ و در نواحی دارای بار خنثی برابر با صفر است. همان طور که قبلاً گفته شد، در این شکل کانتورهای غلظت فقط در محدوده‌ی $C \leq 0.7$ نمایش داده شده‌اند تا نمایش بهتری از عملکرد اختلاط قابل رؤیت باشد. در قسمت عمده‌ای از حجم ریزه‌مgra که میدان غلظت آن نشان داده نشده است، اختلاط در حد اندکی صورت گرفته است و فقط در فضای مجاور فصل مشترک دو سیال است که میدان غلظت آن در شکل قابل مشاهده است، اختلاط کمی صورت گرفته است. توجه کنید که مطابق شکل (۹) زمانی که این الگوهای ناهمگنی روی صفحات x-z قرار دارند، عملکرد اختلاطی آنها کاملاً قابل توجه است. در حالی که با استقرار این ناهمگنی‌ها در صفحه‌ی x-y عملکرد اختلاطی آنها حتی از کانال همگن نیز کمتر می‌شود و لذا مزایای خود را در تأمین اختلاط از دست می‌دهند. موازی بودن صفحات چرخش گرداهها با صفحه‌ی فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط باعث می‌شود تا این وضعیت‌ها به لحاظ اختلاطی ناکارآمد شوند.

در جریان‌های مورد بررسی در شکل (۱۰ و ۹) میدان الکتریکی خارجی در راستای محور x و به‌موازات طول صفحه‌ی فصل مشترک دو سیال اعمال شده و لذا سرعت‌های لغزشی در امتداد جریان اصلی به وجود می‌آیند. چنان‌چه جهت میدان الکتریکی خارجی در امتداد جریان نباشد و به صورت عرضی یعنی در جهت y و z باشد الگوهای متفاوتی برای جریان به وجود می‌آید. انتظار می‌رود که در شرایط یکسان میدان‌های عرضی بهبود بیشتری در میزان راندمان اختلاط داشته باشند چون در امتداد عرضی هیچ جریان غالب حاضر نیست و برای سرعت‌های لغزشی عرضی هیچ مانع تضعیف‌کننده وجود ندارد.

جهت x اعمال می‌شود، گردابهای ایجادشده به‌موازات صفحه‌ی فصل مشترک دو سیال شکل می‌گیرد و کماکان فصل مشترک دو سیال به صورت یک صفحه‌ی مسطح باقی می‌ماند بدون این که دچار اعوجاج گردد. در این حالت تنها اثرات منفی ناشی از حضور گردابه وجود دارد و لذا راندمان اختلاط حتی کاهش می‌یابد.



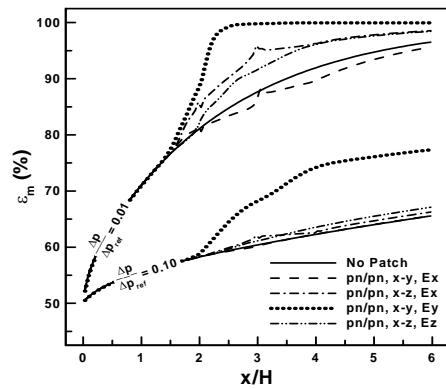
شکل ۱۱ میدان‌های غلظت و جریان مربوط به نمودار شکل (۱۰) با $\Delta p = 0.03 \Delta p_{ref}$ ، حالتی که صفحه‌ی چرخش گردابهای موازی با فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط است.

برای درک بهتر توضیحات داده شده، میدان‌های جریان مربوط به شکل (۱۰) و برای $\Delta p = 0.03 \Delta p_{ref}$ به صورت سه‌بعدی در شکل (۱۱) نمایش داده شده است. در این شکل برای وضوح بیشتر مقادیر سرعت‌های لغزشی فقط در صفحه‌ی $z=0$ نمایش داده شده است. در این صفحه نواحی دارای بار مثبت، منفی و خنثی به‌ترتیب با رنگ‌های تیره، روشن و سفید

بیشتر دچار اعوجاج نماید.

دو وضعیت دیگر یعنی وضعیت‌های E_y , E_x - x - y , E_z , E_x , در شکل (۱۲) نشان داده شده‌اند. در این وضعیت‌ها میدان‌های الکتریکی به صورت عرضی اعمال شده‌اند. با استفاده از امکانات نرم‌افزار tecplot یک خط از ذرات سیال که در ورود به ریز‌ مجررا دارای غلظت‌های متفاوت بوده‌اند، در طول ریز‌ مجررا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برای این که اثر اختلاط روی آن‌ها مشاهده شود، هر ذره با رنگ متناسب با غلظت محلی آن موضع نشان داده شده است. در وضعیت اول از شکل (۱۳) که با E_x - x - z , E_z مشخص شده است، سرعت‌های لغزشی به صورت عرضی هستند و در این جهت هیچ عامل و یا رقیب مزاحمی (مانند جریان اصلی) وجود ندارد و لذا این سرعت‌ها به راحتی باعث اعوجاج فصل مشترک می‌گردند. از طرف دیگر گردابه‌ها در صفحاتی چرخش دارند که عمود بر صفحه فصل مشترک است و از این رو اختلاط بهبود می‌یابد. اما وضعیت گردابه‌ها به صورتی نیست که خطوط بسته‌ی گردابه صفحه فصل مشترک را قطع نماید.

وضعیت دوم از شکل (۱۳) مربوط به حالتی است که اختلاط در آن بیشینه‌ی مقدار خود را در بین حالات بررسی شده را دارد. این وضعیت بیشینه اختلاط (یعنی وضعیت E_y , E_x - x - y , E_z) دارای چند مشخصه است: اول این که سرعت‌های لغزشی به صورت عرضی هستند. دوم این که گردابه‌های جریان به صورت عمود بر صفحه فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط چرخش می‌کنند و سومین مشخصه این است که خطوط بسته‌ی گردابه‌ها صفحه فصل مشترک را قطع می‌کنند. مجموعه این مزايا باعث شده است تا این وضعیت بیشترین میزان اختلاط را مهیا نماید. برای جمع‌بندی این مطالب جدول (۱) تهیه شده است. در این جدول خصوصیات جریانی مربوط به وضعیت‌های شکل (۱۲) و مزايا این‌ها برای اختلاط با اعداد یک (در صورت داشتن



شکل ۱۲ راندمان اختلاط در طول ریز‌ مجررا برای دو اختلاف فشار مختلف و موقعیت‌های متفاوت الگوی (a) روی صفحات ریز‌ مجررا

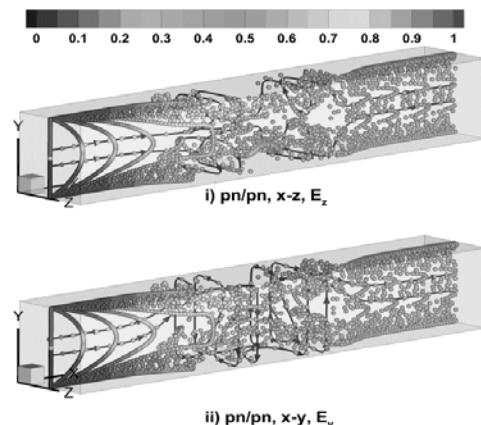
با توجه به موقعیت صفحه‌ی فصل مشترک دوسیال و محل صفحات ناهمگنی چهار انتخاب برای قرار گرفتن یک الگوی بار ثابت (در اینجا الگوی بار (b) در نظر گرفته شده) روی دیواره‌های ریز‌ مجررا وجود دارد. در شکل (۱۲) راندمان اختلاط مربوط به این چهار آرایش نمایش داده شده است. نمودارهای با خط توپر مربوط به ریز‌ مجرای همگن است. نمودارهای خط‌چین مربوط به ریز‌ مجررا با الگوی بار (a) یعنی (pn/pn) روی دیواره‌های جلو و پشتی یعنی صفحات x - y به همراه میدان اعمالی در جهت x یعنی E_x است. این وضعیت روی شکل (۱۲) به صورت pn/pn , x - y , E_x خلاصه شده است و به صورت مشابه برای سایر حالات نامگذاری بر مبنای صفحات ناهمگنی و جهت میدان الکتریکی اعمالی صورت گرفته است. در بین این چهار وضعیت دو وضعیت جهت x هستند. این دو وضعیت به صورت مشروح در شکل‌های (۹-۱۱) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در اینجا فقط به این نکته بسنده می‌کنیم که در بین این دو وضعیت که الگوی بار و جهت میدان یکسان است وضعیتی راندمان مطلوب دارد که گردابه‌های موجود در میدان جریان آن صفحه فصل مشترک دو سیال را

گیرد. هر چند که برای ارزیابی کمی اختلاط نیاز به یک شاخص مناسب است. به خصوص اینکه نتایج جدول فوق در یک افت فشار مشخص ارائه شده است و همان گونه که شکل‌های (۹، ۱۰، ۱۲) نشان می‌دهند با تغییر میزان اختلاف فشار اعمالی بر ریز مجراء، میزان راندمان اختلاط تغییر می‌کند به نحوی که در اختلاف فشارهای کمتر مقدار راندمان اختلاط بیشتر است. دلیل این مطلب این است که در اختلاف فشارهای کم، سرعت متوسط جریان اندک است و سیال مدت زمان بیشتری را در قسمت مخلوط‌کننده سپری می‌کند. بنابراین، اختلاط بیشتری حاصل می‌شود. با وجودی که کاهش اختلاف فشار منجر به افزایش راندمان اختلاط می‌شود، اما بدون وجود اختلاف فشار مناسب جریان و اختلاط حاصل نمی‌شود. از طرف دیگر مشاهده می‌شود که راندمان اختلاط محاسبه شده در هر مقطع با پیش‌روی سیال در طول ریز مجراء همواره رشد صعودی دارد و در انتهای ریز مجراء ($x=L$) حداقل مقدار خود را دارد. به‌منظور بررسی مجموع این عوامل مؤثر (اختلاف فشار، نحوه آرایش بارها و طول ریز مجراء) بر راندمان اختلاط لازم است معیاری بنا شود که مرجع ارزیابی در آن راندمان اختلاط در خروج از ریز مجراء ($x=L$) باشد. این معیار مناسب راندمان نسبی اختلاط در ریز مجراء است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$E_{Ch,re} = \frac{\varepsilon_m(L)}{\varepsilon_{m,no\ patch}(L)} \quad (12)$$

در این رابطه صورت کسر معرف میزان راندمان اختلاط در خروجی ریز مجراء ($x=L$) است و مخرج کسر معرف میزان راندمان اختلاط در خروجی ریز مجرای بدون بار (یا حتی باردار کاملاً همگن) در همان اختلاف فشار است. بنابراین راندمان نسبی اختلاط در یک ریز مجراء به دو طریق می‌تواند به

مزیت) و صفر (در صورت نداشتن مزیت) ارزیابی شده‌اند.



شکل ۱۳ میدان‌های غلظت و جریان مربوط به وضعیت‌های $\Delta p = 0.01 \Delta p_{ref}$ برای $x-Z$, E_z و $x-y$, E_y ، حالاتی که صفحه‌ی چرخش گردابه‌ها عمود بر فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط است

جدول ۱ ارزیابی شاخص‌های مهم در میزان اثر اختلاطی گردابه

$x-z E_z$	$x-y E_y$	$x-z E_x$	$x-y E_x$	وضعیت: صفحه‌ی ناهمگنی و جهت میدان الکتریکی
۱	۱	۰	۰	سرعت لغزشی عرضی
۱	۱	۱	۰	تعامد صفحه‌ی گردابه و فصل مشترک
۰	۱	۰	۰	تقاطع خطوط گردابه و فصل مشترک
۲	۳	۱	۰	تعداد مزایا برای اختلاط
۲	۱	۳	۴	رتبه اختلاط با توجه به شکل (۱۲)

نتایج جدول (۱) نشان می‌دهد که شاخص‌های معرفی شده می‌توانند به خوبی برای ارزیابی کیفی اختلاط مربوط به ریز‌مخلوط‌گرهای مختلف مورد استفاده قرار

ریزمجرا طولانی است. این زمان طولانی باعث می‌شود که میزان اختلاط در خروجی ریزمجرا افزایش یابد. در نتیجه مستقل از این که تکه‌های ناهمگنی با آرایش نامتقارن موجود باشند یا نباشند، عملکرد اختلاطی آن تغییری نمی‌کند و راندمان نسبی اختلاط در ریزمجرا به سمت عدد ۱ نزدیک می‌شود. در این حالت پدیده‌ی پخش مولکولی تنها عامل مؤثر در اختلاط است. از طرف دیگر، در اختلاف فشارهای نسبتاً زیاد سیال با سرعت بیشتری از درون ریزمجرا عبور می‌کند و فرصت اختلاط کم‌تری دارد. به علاوه این اختلاف فشار زیاد و سرعت بیشتر ناشی از آن، از قدرت گردابه‌ها در نواحی میانی ریزمجرا می‌کاهد. در نتیجه وجود ناهمگنی‌ها و جایه‌جایی آشوبناک ناشی از آن اثر قابل توجهی در عملکرد اختلاط ندارد به نحوی که با افزایش بیشتر اختلاف فشار، راندمان نسبی اختلاط ریزمجرا مجدداً به سمت ۱ میل می‌کند. در این حالت نیز پخش مولکولی پدیده‌ی غالب در فرآیند اختلاط است. در اختلاف فشارهای میانی، علاوه بر پدیده‌ی پخش مولکولی، جایه‌جایی آشوبناک ناشی از حضور تکه‌های ناهمگنی و جایه‌جایی ناشی از اعمال Δp روی فرآیند فرایند اختلاط اثر هم‌افزایی دارد و لذا راندمان نسبی اختلاط دارای یک مقدار حداقل است.

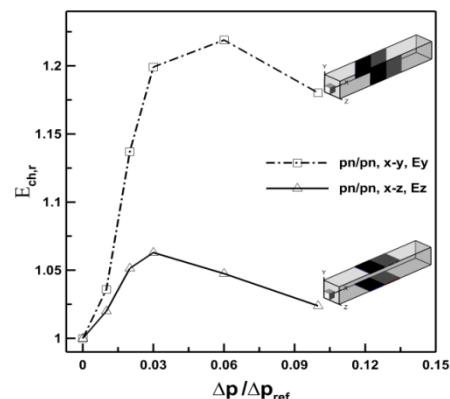
ظرفیت اختلاطی ریزمجرا / ریزمخلوطگر. معیار مناسب برای ارزیابی اختلاط در یک ریزمخلوطگر را با توجه به دبی جرمی سیال عامل تحت عنوان ظرفیت اختلاطی مشابه ظرفیت حرارتی در یک مبدل تعریف می‌کنیم. برای یک ریزمخلوطگر با دبی \dot{m} ، میزان اختلاط ورودی $\varepsilon_{m,in}$ و میزان اختلاط خروجی $\varepsilon_{m,out}$ میزان ظرفیت اختلاطی برابر است با:

$$Q_{mixing} = \dot{m} (\varepsilon_{m,out} - \varepsilon_{m,in}) \quad (13)$$

ظرفیت اختلاطی می‌تواند معرف کیفیت اختلاط و

خدمت گرفته شود. اولاً نشان دهد که در یک ریزمجرا با طول و اختلاف فشار مشخص، نحوه‌ی آرایش بارها (اثر خالص ناحیه‌ی میانی) چه تأثیری بر راندمان اختلاط خروجی دارد، ثانیاً در یک ریزمجرا با آرایش بار مشخص، اختلاف فشار اعمالی چه تأثیری بر راندمان اختلاط خروجی دارد.

در پاسخ به این سؤال که روند بهبود راندمان با افزایش اختلاف فشار چگونه می‌نماید شکل (۱۴) رسم شده است. در این شکل تغییرات راندمان نسبی اختلاط، $E_{ch,r}$ ، بر حسب تغییرات اختلاف فشار Δp برای آرایش‌های نشان داده شده در شکل (۱۲) یعنی $(pn/pn, x-y, E_y)$ و $(pn/pn, x-z, E_z)$ و وضعیت‌های نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش اختلاف فشار، ابتدا مقدار راندمان نسبی اختلاط زیاد می‌شود و پس از عبور از یک مقدار حداقل شروع به کاهش می‌نماید. بنابراین یک نقطه‌ی بهینه برای میزان اختلاف فشار وجود دارد که در آن نقطه مقدار راندمان نسبی اختلاط به حداقل می‌رسد. اندازه‌ی اختلاف فشار بهینه برای هر آرایش متفاوت است.



شکل ۱۴ تغییرات راندمان نسبی اختلاط ($E_{ch,r}$) بر حسب اختلاف فشار Δp برای آرایش‌های بررسی شده در شکل (۱۲)

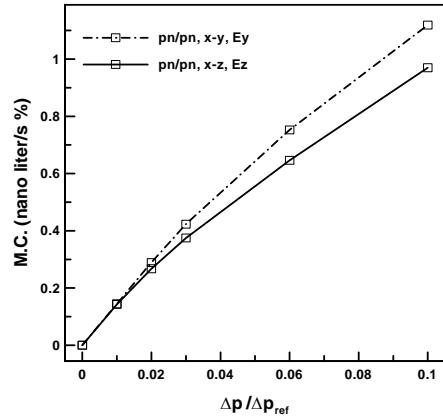
در اختلاف فشارهای کم، میزان سرعت متوسط سیال بسیار کم می‌باشد. بنابراین، زمان عبور سیال از

محرك معرفی شده‌اند. مطالعه‌ی انجام شده نشان داد که میزان اختلاط درون ریز مخلوط‌گرهای سه‌بعدی به شدت از میزان اختلاف فشار اعمالی بر ریز‌ مجراء، نحوه‌ی چیدمان ناهمگنی‌ها و نحوه حرکت گردابه‌ها درون ریز‌ مجراء متأثر می‌شود. مشخص شد که نحوه چرخش گردابه‌های جریان نسبت به صفحه‌ی فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط عامل بسیار مهمی در میزان راندمان اختلاط است به نحوی که در برخی موارد ممکن است وجود نواحی چرخشی اثر مثبتی بر میزان راندمان اختلاط نداشته باشد. با ترکیب دو جریان الکترواسموتیک و فشار-محرك در یک ریز‌ مجراء تنظیم مناسب تکه‌های ناهمگنی بار، به سادگی می‌توان یک ریز مخلوط‌گر الکترواسموتیکی را با اختلاط قابل کنترل طراحی نمود. مطالعات این پژوهش نشان می‌دهد که توجه به برخی مشخصه‌های جریان درون ریز مخلوط‌گر می‌توان تا حد زیادی درباره‌ی راندمان اختلاطی ریز مخلوط‌گر قضاوت نمود. برای ارزیابی کمی میزان اختلاط نیز معیارهای راندمان اختلاط، راندمان نسبی اختلاط و ظرفیت اختلاطی معرفی و تعریف شد که با استفاده از آن‌ها میزان دقیق اختلاط مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که هر چند در اختلاف فشارهای کم میزان راندمان اختلاط افزایش می‌یابد اما ظرفیت اختلاطی ریز‌ مجراء کاهش می‌یابد. به علاوه مشاهده شد که هر چه آرایش تکه‌های ناهمگنی بار روی دیوارهای وضعیت گردابه‌ها نسبت به صفحه فصل مشترک دو سیال مورد اختلاط نامتقارن‌تر باشد، عملکرد اختلاطی ریز‌ مجراء بهتر خواهد بود.

نتیجه‌ی مهم دیگر این که در اختلاف فشارهای اندک و یا خیلی زیاد وجود تکه‌های ناهمگنی بار روی دیوارهای ریز‌ مجراء اثر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود اختلاط ندارد و در این محدوده از اختلاف فشارها عملکرد

کمیت اختلاط باشد. در شکل (۱۵) ظرفیت اختلاطی (M.C.) برای چند ریز مخلوط‌گر نمایش داده شده است.

با افزایش میزان اختلاف فشار، ظرفیت اختلاطی ریز‌ مجراء در هر دو آرایش بار انتخابی افزایش می‌یابد. شبیه نمودارها برای هر حالت تقریباً ثابت است و مقدار آن به تدریج کاهش می‌یابد. به نحوی که در اختلاف فشارهای نزدیک صفر بیشترین مقدار را دارد و در این نقطه حدی میزان شبیه برای هر دو حالت مساوی است. لذا معلوم می‌شود که در اختلاف فشارهای کم با تغییر میزان اختلاف فشار، بهبود ظرفیت اختلاطی بیشتر است. بنابراین، میزان ظرفیت اختلافی می‌تواند به سادگی با افزایش میزان اختلاف فشار اعمالی تنظیم شود.



شکل ۱۵ تغییرات ظرفیت اختلاطی به ازای تغییرات اختلاف فشار Δp برای آرایش‌های شکل (۱۳).

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در این مقاله فرآیند اختلاط تحت اثرات الکتروکینتیک درون ریز مخلوط‌گرهای غیر فعال با بار الکتریکی ناهمگن در دیواره برای هندسه‌ی سه‌بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است و شاخصه‌های کیفی و کمی مؤثر بر اختلاط در جریان ترکیبی الکترواسموتیک و فشار

اختلاطی ریزمجراهای همگن و ناهمگن به یکدیگر نزدیک می‌باشد. برای هر ریزمجرا یک اختلاف فشار خاص وجود دارد که در آن بیشترین میزان اختلاط گیرد.

مراجع

- Chen, J-K., Luo, W-J. and Yang, R-J., "Electroosmotic flow driven by DC and AC electric fields in curved microchannels", *Jap. Journal of Appl. Phys.*, Vol. 45, pp. 7983–7990, (2006).
- Dreher, S., Kockmann, N. and Woias, P., "Characterization of laminar transient flow regimes and mixing in T-shaped micromixers", *Heat Transfer Engineering*, Vol. 30(1–2), pp. 91–100, (2009).
- Chang, C.C. and Yang R.J., "Electrokinetic mixing in Microfluidic systems", *Microfluid Nanofluid*, Vol. 3, pp. 501–525, (2007).
- Chung Y.C., Hsu Y.L., Jen C.P., Lu M.C. and Lin Y.C., "Design of passive mixers utilizing microfluidic self-circulation in the mixing chamber", *Lab on a Chip*, Vol. 4, pp. 70–77, (2004).
- Chen, J.M., Horng, T.L. and Tan, W.Y., "Analysis and measurements of mixing in pressure-driven microchannel flow", *Journal of Microfluid and Nanofluid*, Vol. 2, pp. 455–469, (2006).
- Yu, S., Jeon, T.J. and Kim, S.M., "Active micromixer using electrokinetic effects in the micro/nanochannel junction", *Chemical Engineering Journal*, Vol. 197, pp. 289–294, (2012).
- Bockelmann, H., Heuveline, V. and Barz, D.P.J., "Optimization of an electrokinetic mixer for microfluidic applications", *Biomicrofluidic*, Vol. 6(2), 024123, (2012).
- Wong, S.H., Ward, M.C.L. and Wharton, C.W., "Micro T-mixer as a rapid mixing micromixer", *Sensors Actuators B*, Vol. 100, pp. 365–385, (2004).
- Ou, J., Moss, G.R. and Rothstein, J.P., "Enhanced mixing in laminar flows using ultrahydrophobic surfaces", *Physical Review E*, Vol. 76, pp. 016304, (2007).
- Knight, J.B., Vishwanath, A., Brody, J.P. and Austin, R.H., "Hydrodynamic focusing on a silicon chip:mixing nanoliters in microseconds", *Physical Review Letter*, Vol. 80, pp. 3863–3866, (1998).
- Yang, R.J., Chang, C.C., Huang, S.B. and Lee, G.B., "A new focusing model and switching approach for electrokinetic flow inside microchannels", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 15, pp. 2141–2148, (2005).
- Hardt, S., Pennemann, H. and Schönfeld, F., "Theoretical and experimental characterization of a low-Reynolds number split and-recombine mixer", *Journal of Microfluid and Nanofluid*, Vol. 2, pp. 237–248, (2006).
- Aref, H., "Stirring by chaotic advection", *Journal of Fluid Mechanics*, Vol. 143, pp. 1–21, (1984).
- Howell Jr, P.B., Mott, D.R., Ligler, F.S., Golden, J.P., Kaplan, C.R. and Oran, E.S.A., "combinatorial approach to microfluidic Mixing", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 18, pp.115019(7), (2008).

15. Cho, C.C., Chen, C.L. and Chen, C.K., "Mixing enhancement of electrokinetically-driven non-Newtonian fluids in microchannel with patterned blocks", *Chemical Engineering Journal*, Vol. 191, pp. 132-140, (2012).
16. Erickson, D. and Li, D., "Influence of Surface Heterogeneity on Electrokinetically Driven Microfluidic Mixing", *Langmuir*, Vol. 18, pp. 1883–1892, (2002).
17. Fushinobu, K. and Nakata, M., "An experimental and numerical study of a liquid mixing device for Microsystems", *Transaction of ASME, Journal of Electronic Packaging*, Vol. 127, pp. 141–146., (2005).
18. Lee, L.M., Hau, W.L.W., Lee, Y.K. and Zohar, Y., "In-plane vortex flow in microchannels generated byelectroosmosis with patterned surface charge", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 16, pp. 17–26., (2006)
19. Zhang, J., He, G. and Liu, F., "Electro-osmotic flow and mixing in heterogeneous microchannels", *Physical Review E*, Vol. 73, pp. 056305, (2006).
20. Lee, Y.K., Lee, L.M., Hau, W.L.W. and Zohar, Y., "Two-dimensional analysis of electrokinetically driven out-of-plane vortices in a microchannel liquid flow using patterned surface charge", *MEMS*, Vol. 16, pp. 58–67, (2007).
21. Horiuchi, K., Dutta, P. and Ivory, C.F., "Electroosmosis with step changes in zeta potential in microchannels", *AICHE*, Vol. 53, pp. 2521–2533, (2007).
22. Qian, S. and Bau, H.H., "A chaotic electroosmotic stirrer", *Analytical Chemistry*, Vol. 74, pp. 3616–3625 (2002).
23. Chen, C.K. and Cho, C.C., "Electrokinetically driven flow mixing utilizing chaotic electric fields", *Journal of Microfluid and Nanofluid*, Vol. 5, pp. 785–793, (2008).
24. Chang, C.C. and Yang, R.J., "A particle tracking method for analyzing chaotic electroosmotic flow mixing in 3-D microchannels with patterned charged surfaces", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 16, pp. 1453–1462, (2006).
25. Mirbozorgi, S.A., Niazmand, H. and Renksizbulut, M., "Electro-osmotic flow in reservoir-connected flat microchannel with non-uniform zeta potential", *Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME*, Vol. 128(6), pp. 1133–1143, (2006).
26. Ramirez, J.C. and Conlisk, A.T., "Formation of vortices near abrupt nano-channel height changes in electro-osmotic flow of aqueous solutions", *Biomedical and Microdevices*, Vol. 8, pp. 235–330, (2006).
27. Meisel, I. and Ehrhard, P., "Electrically-excited (electroosmotic) flows in microchannels for mixing applications", *European Journal of Mechanics B/Fluids*, Vol. 25, pp. 491–504, (2006).

28. Cummings, E.B., Griffiths, S.K., Nilson, R.H. and Paul, P.H., "Conditions for similitude between the fluid velocity and electric field in electroosmotic flow", *Analytical Chemistry*, Vol. 72, pp. 2526–2532, (2000).
29. Santiago, J.G., "Electroosmotic flows in microchannels with finite inertial and pressure forces", *Analytical Chemistry*, Vol. 73, pp. 2353–2365, (2001).
30. Stroock, A.D., Weck, M., Chiu, D.T., Huck, W.T.S., Kenis, P.J.A., Ismagilov, R.F. and Whitesides, G.M., "Patterning electro-osmotic flow with patterned surface charge", *Physical Review Letters*, Vol. 84(15), pp. 3314, (2000).
31. Hau, W.L.W., Trau, D.W., Sucher, N.J., Wong, M. and Zohar, Y., "Surface-chemistry technology for microfluidics", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 13(2), pp. 272-278, (2003).
32. Schasfoort, R.B.M., Schlautmann, S., Hendrikse, J., van den Berg, A., "Field-effect flow control for microfabricated fluidic networks", *Science*, 286(5441), pp. 942-945, (1999).
33. Loucaides, N., Ramos, A., Georghiou, G.E., "Configurable AC electroosmotic pumping and mixing", *Microelectronic Engineering*, Vol. 90, pp. 47-50, (2012).
34. Pacheco, J.R., Pacheco-Vega, A. and Chen, K.P., "Mixing-dynamics of a passive scalar in a three-dimensional microchannel", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 54, pp.959–966, (2011).
35. Lynn, N.S., Henry, C.S. and Dandy, D.S., "Microfluidic mixing via transverse electrokinetic effects in a planar microchannel", *Journal of Microfluid and Nanofluid*, Vol. 5, pp. 493–505, (2008).
36. Kang, T.G. and Kwon, T.H., "mixing analysis of chaotic micromixers", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 14, pp. 891–899, (2004).
37. Wang D., Summers J.L. and Gaskell, P.H., "Modelling of electrokinetically driven mixing flow in microchannels with patterned blocks", *Computers and Mathematics with Applications*, Vol. 55(7), pp. 1601-1610, (2008).
38. Chang, C.C. and Yang, R.J., "Computational analysis of electrokinetically driven flow mixing in microchannels with patterned blocks", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 14(4), pp. 550-558, (2004).
39. Rhie, C.M. and Chow, W.L., "Numerical Study of the Turbulent Flow past an Airfoil with Trailing Edge Separation", *AIAA Journal*, Vol. 21, pp. 1525–1532, (1983).